



GaN n型 基板 標準仕様

グレード	Ultra	Production	Reserch	Dummy
サイズ	2インチ			
面方位	(0001) ± 0.5° / (0001) off angle toward M-axis			
厚さ	350.0 ± 25.0μm			
OF方位	<1-110> ± 0.5°			
IF方位	<11-20> ± 3°			
EPD	< 3.0 × 10 ⁶ cm ² (hole : ≦ 0.3cm ²)			
抵抗率	< 0.5Ωcm			
TTV	≦ 15μm			
Bow	≦ 20μm			≦ 40μm
面仕上げ	片面, 両面鏡面研磨 (Ga面)			
使用可能エリア	> 90%		> 80%	> 70%

直径	(mm)	50.8 ± 1.0	—	—
OF長さ	(mm)	16.0 ± 1.0	—	—
IF長さ	(mm)	8.0 ± 1.0	—	—



GaN 半絶縁型 基板 標準仕様

グレード	Ultra	Production	Reserch	Dummy
サイズ	2インチ			
面方位	(0001) ± 0.5° / (0001) off angle toward M-axis			
厚さ	350.0 ± 25.0μm			
OF方位	<1-110> ± 0.5°			
IF方位	<11-20> ± 3°			
EPD	< 3.0 × 10 ⁶ cm ² (hole : ≦ 0.3cm ²)			
抵抗率	> 1.0 × 10 ⁶ Ωcm			
TTV	≦ 15μm			
Bow	≦ 20μm			≦ 40μm
面仕上げ	片面, 鏡面研磨 (Ga面)			
使用可能エリア	> 90%		> 80%	> 70%

直径	(mm)	50.8 ± 1.0	—	—
OF長さ	(mm)	16.0 ± 1.0	—	—
IF長さ	(mm)	8.0 ± 1.0	—	—

※各種ウエハーの仕様はご相談に応じます。